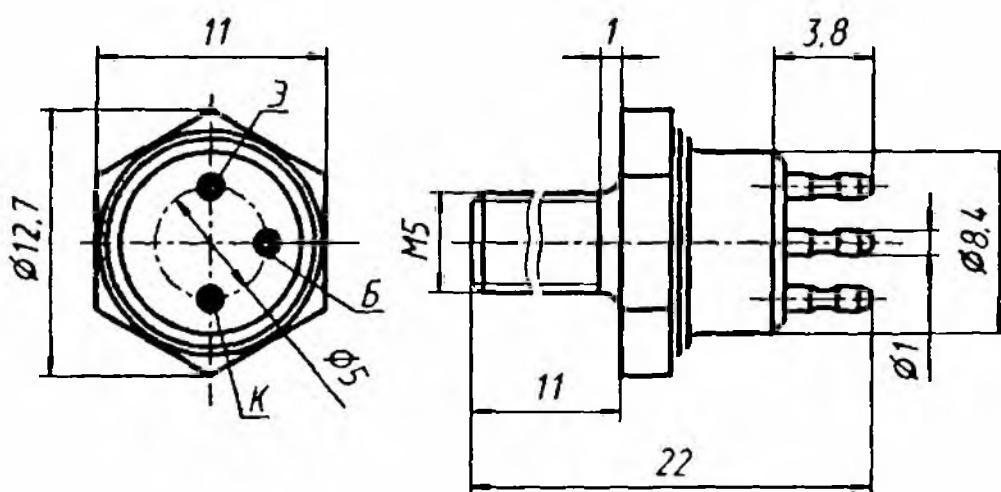


2Т606А, КТ606А, КТ606Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах на частотах выше 100 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и монтажным винтом. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более 6 г.

2Т606А, КТ606(А,Б)



Электрические параметры

Выходная мощность на частоте $f = 400$ МГц, при $U_{кз} = 28$ В, не менее:

2Т606А, КТ606А	0,8 Вт
КТ606Б	0,6 Вт

Коэффициент усиления по мощности на частоте $f = 400$ МГц, не менее
 2,5 |

 типичное значение

 3* |

Коэффициент полезного действия коллектора на частоте $f = 400$ МГц, не менее

 35% |

Модуль коэффициента передачи тока на частоте $f = 100$ МГц при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 100$ А, не менее:

2Т606А, КТ606А	3,5
КТ606Б	3

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 200$ мА, $I_b = 40$ мА, не более

 1* В |

Постоянная времени цепи обратной связи на частоте $f = 5$ МГц при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, не более:

2Т606А, КТ606А	10 нс
КТ606Б	12 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 28$ В, $f = 5$ МГц, не более	10 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$, $f = 5$ МГц, не более	27 пФ
Критический ток коллектора на частоте $f = 100$ МГц при $U_{кэ} = 10$ В, не менее	100 мА
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кэ} = 65$ В, $R_{эб} = 100$ Ом, не более: $T = +25$ °С:	
2Т606А	1 мА
КТ606А, КТ606Б	1,5 мА
$T = +85$ °С для КТ606А, КТ606Б	3 мА
$T = +125$ °С для 2Т606А	2 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более:	
2Т606А	0,1 мА
КТ606А, КТ606Б	0,3 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{эб} \leq 100$ Ом	65 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{эб} \leq 100$ Ом:	
2Т606А	75 В
КТ606А, КТ606Б	70 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	4 В
Постоянный ток коллектора	0,4 А
Импульсный ток коллектора	0,8 А
Постоянный ток базы	0,1 А
Средняя рассеиваемая мощность ¹ в динамиче- ском режиме при $T_k \leq +40$ °С	2,5 Вт

¹ При $T_k > +40$ °С

$$P_{к, ср, макс} = (T_n - T_k) / 44, \text{ Вт.}$$

Тепловое сопротивление переход—корпус	44 °С/Вт
Температура р-п перехода:	
2Т606А	+150 °С
КТ606А, КТ606Б	+120 °С
Температура корпуса:	
2Т606А	+125 °С
КТ606А, КТ606Б	+85 °С

Температура окружающей среды:

2Т606А	-60... $T_K =$ = +125 °С
КТ606А, КТ606Б	-45... $T_K =$ = +85 °С

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть не менее 2,5. Неплоскостность контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 0,03 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 1 мм от корпуса транзистора паяльником, нагретым до температуры не более +250 °С в течение времени не более 3 с. Целесообразно осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки.